

Член-корреспондент АН СССР В. Г. ЛЕВИЧ, Б. М. ГРАФОВ

ЭФФЕКТ ВЫПРЯМЛЕНИЯ НА ИДЕАЛЬНО ПОЛЯРИЗУЕМОМ ЭЛЕКТРОДЕ

Представляет принципиальный интерес провести достаточно полное количественное исследование процесса прохождения тока через простейшую электрохимическую систему — неподвижный раствор бинарного электролита. В этой работе будет рассчитан средний сдвиг потенциала, возникающий при прохождении синусоидального тока через ячейку с идеально поляризуемым электродом. Как будет показано ниже, прохождение синусоидального сигнала сопровождается эффектом выпрямления. Измерение последнего позволяет в принципе найти величину потенциала в плоскости наибольшего приближения ионов (так называемый пси-прим потенциал).

Прохождение синусоидального тока через идеально поляризуемый электрод связано с периодическим зарядением и разрядением двойного слоя в частности, с синусоидальными колебаниями напряженности поля в гельмгольцевском слое. Изменение падения напряжения в гельмгольцевском слое пропорционально колебаниям напряженности поля и тем самым носит синусоидальный характер. Поэтому среднее значение падения напряженности в гельмгольцевском слое равно нулю.

Мы будем предполагать, что значение пси-прим потенциала достаточно велико, так что можно считать, что заряд в диффузном слое фактически определяется лишь одним сортом ионов. Для определенности будем их считать отрицательными. Тогда для вычисления среднего значения падения напряжения в диффузном слое можно воспользоваться выражением (1)

$$\frac{1}{2} \bar{\mathcal{E}}^{*2} = \kappa_-^2 \frac{\tilde{n}_-^{(d)}}{n_-^0} e^{z_-(\psi^* - \tilde{\psi}^{(d)})}. \quad (1)$$

Здесь и дальше используются обозначения работы (1). Обычно (2) при рассмотрении явления фарадеевского выпрямления принимается, что ячейка поляризуется током достаточно малой амплитуды. Мы будем считать, что условие малости амплитуды выполняется. Тогда из (1) с точностью до членов второго порядка малости получим

$$\begin{aligned} \bar{\mathcal{E}}^* \bar{\mathcal{E}} + \frac{1}{2} \bar{\mathcal{E}}^{*2} = \kappa_-^2 e^{z_-\bar{\psi}^*} \left[\frac{\tilde{n}_-^{(d)}}{n_-^{(0)}} + z_-(\tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)}) + \right. \\ \left. + \frac{\tilde{n}_-^{(d)}}{n_-^0} z_-(\tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)}) + \frac{1}{2} z_-^2 (\tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)})^2 \right]. \quad (2) \end{aligned}$$

Нам нужно вычислить среднее значение $\langle \tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)} \rangle$

$$\langle \tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)} \rangle = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} [\tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)}] dt$$

по периоду синусоидального тока $2\pi/\omega$. Выполняя усреднение в (2), получим

$$\begin{aligned} z_- \langle \tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)} \rangle = \left\langle \frac{\tilde{n}_-^{(d)}}{n_-^0} z_-(\tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)}) \right\rangle + \\ + \frac{1}{2} z_-^2 \langle (\tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)})^2 \rangle - \langle \bar{\mathcal{E}}^{*2} \rangle \kappa_-^2 e^{-z_-\bar{\psi}^*}. \quad (3) \end{aligned}$$

При вычислении средних значений от величин второго порядка малости типа $\langle \tilde{n}_-^{(d)} (\tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)}) \rangle$ можно воспользоваться выражениями, полученными при удержании лишь величин первого порядка малости, т. е. выражениями, используемыми при вычислении импеданса ячейки (1). Усреднение величин второго порядка малости проводится нами именно таким способом.

Для вычисления среднего сдвига потенциала в диффузионной области воспользуемся уравнением переноса

$$j_- = D_- \left(-\frac{\partial n_-}{\partial x} - z_- g n_- \right).$$

Из этого уравнения с точностью до величин второго порядка малости получим

$$\langle z_- \tilde{g} \rangle = \frac{1}{n_-^0} \left\langle \frac{\tilde{n}_-}{n_-^0} \frac{\partial \tilde{n}_-}{\partial x} \right\rangle + \frac{1}{n_-^0 D_-} \langle \tilde{j}_- \tilde{n}_- / n_-^0 \rangle. \quad (4)$$

Значение среднего сдвига потенциала в диффузионной области получается из (4) непосредственным интегрированием. Если сложить получающееся при этом выражение с (3), то для среднего сдвига непряжения во всей ячейке получим

$$\begin{aligned} z_- \langle \tilde{V} \rangle &= z_- \langle \tilde{\psi}^* - \tilde{\psi}^{(d)} \rangle + z_- \langle \tilde{\psi}^{(d)} - \tilde{\psi}^{(L)} \rangle = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{D_+ z_+}{D_+ z_+ + D_- z_-} \right)^2 \frac{i_0^2}{z_-^2 e^2 n_-^0 D_- \omega} - \frac{1}{4} e^{-z_- \bar{\psi}^*} \frac{4\pi i_0^2}{\varepsilon \theta \omega^2 n_-^0}, \end{aligned} \quad (5)$$

где i_0 — амплитуда синусоидального тока.

Интересно отметить, что полный сдвиг потенциала определяется двумя слагаемыми, имеющими разный знак и по-разному зависящими от частоты. Поэтому при некоторой частоте $\omega = \omega_{\text{крит}}$ значение среднего сдвига потенциала проходит через нуль. Из (5) следует, что

$$\begin{aligned} \omega_{\text{крит}} &= \omega_0 e^{-z_- \bar{\psi}^*} \xi^{-1}; \\ \omega_0 &= \frac{4\pi e^2 n_-^0 D_-}{\varepsilon \theta} = \kappa^2 D_-; \quad \xi = \frac{1}{z_-} \left(\frac{D_+ z_+}{D_+ z_+ + D_- z_-} \right)^2. \end{aligned} \quad (6)$$

Зная значение частоты, при которой эффект выпрямления отсутствует, можно определить $\bar{\psi}^*$, т. е. пси-прим потенциал;

$$z_- \bar{\psi}^* = \ln \frac{\omega_0}{\xi \omega_{\text{крит}}}. \quad (7)$$

При $\omega \gg \omega_{\text{крит}}$ выпрямление определяется первым слагаемым в (5), и поэтому сдвиг потенциала обратно пропорционален частоте при неизменной амплитуде тока. При $\omega \ll \omega_{\text{крит}}$ выпрямление определяется вторым слагаемым в (5), и поэтому сдвиг потенциала обратно пропорционален квадрату частоты при неизменной амплитуде тока.

Если заряд в диффузионном слое определяется в основном положительными ионами, то выражение (5) будет опять справедливо, если в нем формально проведем замену индексов $(+) \rightarrow (-)$, $(-) \rightarrow (+)$.

В заключение отметим, что полученные результаты справедливы лишь при условии, что частота ω много меньше частоты релаксации двойного слоя. Порядок величины последней совпадает с $\omega_0 = \kappa^2 D_-$.

Институт электрохимии
Академии наук СССР

Поступило
26 V 1962

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹ В. Г. Левич, Б. М. Графов, ДАН, 146, № 2 (1962). ² Ю. А. Вдовин, ДАН, 120, 554 (1958); G. C. V a r k e r, Trans. Symposium on Electrode Processes, Philadelphia, 1959.